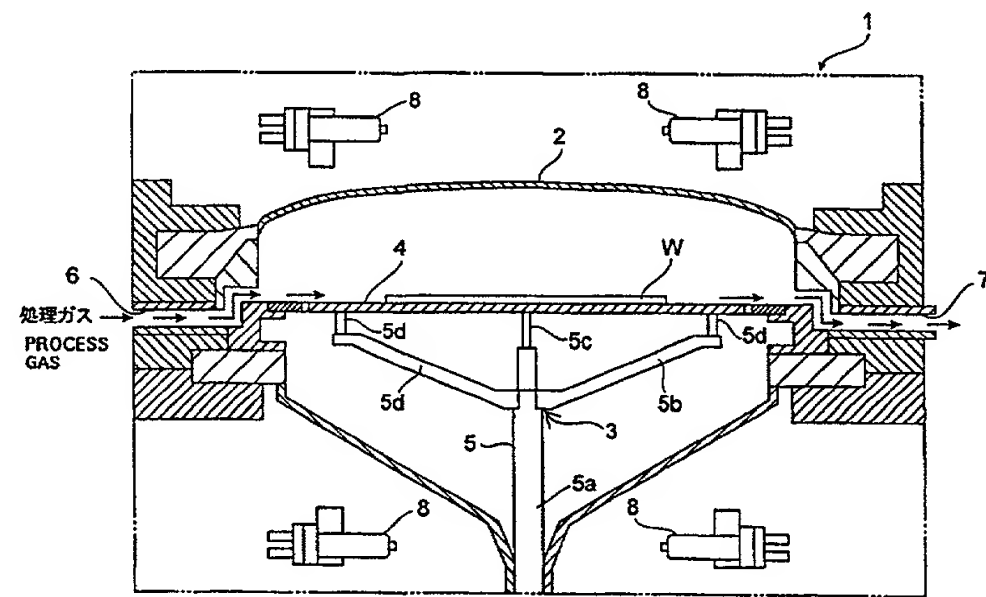


(51) 国際特許分類7 H01L 21/205	A1	(11) 国際公開番号 WO00/24044 (43) 国際公開日 2000年4月27日(27.04.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP99/05753 (22) 国際出願日 1999年10月19日(19.10.99) (30) 優先権データ 特願平10/297087 1998年10月19日(19.10.98) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド (APPLIED MATERIALS INC.)[US/US] 95054 カリフォルニア サンタ クララ パウアーズアベニュー 3050 California, (US) (72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 有村健一 (ARIMURA, Kenichi)[JP/JP] 有馬靖二 (ARIMA, Seiji)[JP/JP] 高木庸司 (TAKAGI, Youji)[JP/JP] 〒286-8516 千葉県成田市新泉14-3 アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社内 Chiba, (JP) (74) 代理人 弁理士 長谷川芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.) 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号 大倉本館 創英国際特許法律事務所 Tokyo, (JP)		(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE) 添付公開書類 国際調査報告書
(54) Title: WAFER SUPPORT OF SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SYSTEM (54) 発明の名称 半導体製造装置におけるウェハ支持器  <p>The diagram illustrates a cross-section of a semiconductor manufacturing system. A processing chamber (1) contains a wafer (W) supported by a susceptor (4). The susceptor is held by a central shaft (5) and three radial arms (5a, 5b, 5c, 5d). Halogen lamps (8) are positioned above and below the chamber. Process gas (6) enters from the left and exits (7) from the right.</p> (57) Abstract An epitaxial growth apparatus includes a processing chamber composed of fused silica, and a wafer support arranged in the processing chamber. Halogen lamps are arranged above and below the processing chamber to heat a semiconductor wafer supported on the wafer support. The wafer support includes a susceptor for holding the wafer and a susceptor support shaft for supporting the susceptor on the lower side. Arms are extended radially from the main shaft of the susceptor support shaft to support the susceptor at three points. Since no projection for support is present under the center of the susceptor, the heat from the lower halogen lamps is not interrupted and the semiconductor wafer can be heated uniformly.		